2D17

## DBP/HOPG 界面における2光子光電子分光

(阪大院理<sup>1</sup>、Jena Univ.<sup>2</sup>)

○森 良亮<sup>1</sup>、國枝 省吾<sup>1</sup>、Tobias Hümpfner<sup>2</sup>、Tino Kirchhübel<sup>2</sup>、山田 剛司<sup>1</sup>、
加藤 浩之<sup>1</sup>、Torsten Fritz<sup>2</sup>、宗像 利明<sup>1</sup>

Two-photon photoemission spectroscopy at DBP/HOPG interface (Osaka Univ.<sup>1</sup>, Jena Univ.<sup>2</sup>)

OR. Mori<sup>1</sup>, S. Kunieda<sup>1</sup>, T. Hümpfner<sup>2</sup>, T. Kirchhübel<sup>2</sup>, T. Yamada<sup>1</sup>, H. S. Kato<sup>1</sup>, T. Fritz<sup>2</sup>, T. Munakata<sup>1</sup>

【序】有機薄膜デバイスの動作原理の解明には、薄膜と基板界面の電子 状態を理解することが必要不可欠である。しかし占有準位に比べ、非占 有準位に関する研究は少ない。本研究では現在太陽電池材料として注目 を集めているtetraphenyldibenzoperiflanthene(DBP)(Fig.1)を高配向性 熱分解グラファイト(HOPG)上に蒸着した系に対して 2 光子光電子 (2PPE)分光を行い、フェルミ準位近傍に存在する占有、非占有準位の帰 属を行った。



Fig.1 DBP 分子の構造

【実験】2PPE 光源には波長可変 Ti:Sa レーザーの第3高調波を用い、レンズで超高真空チャンバー 内のサンプルへ集光した。HOPG は大気中で劈開後、超高真空下で48時間加熱することにより清浄 化した。また DBP は超高真空下で室温基板に蒸着した。光電子はエネルギー分解能20 meV の光電子 分光器(VG: CLAM2)で検出した。膜厚の規定は仕事関数の変化によって行い、測定は全て室温で行っ た。

【結果】Fig.2 に 0.6 ML 膜における波長依存 2PPE スペクトル を示す。横軸はフェルミエネルギーを基準とした中間状態エネ ルギーである。1.45 eV のピーク(赤線)は励起波長によらず、中 間状態でエネルギーが一定であることから非占有準位である。 最高占有軌道(HOMO)由来の準位(-1.15 eV)からのエネルギー 差を考慮し、このピークは最低非占有軌道(LUMO)由来の準位 であると帰属した。この LUMO ピークには赤丸で示すように 1.30 eV に微細構造が見られる。これは光電子放出に伴う正イオ ンの振動励起状態をとらえていると考えられる。LUMO バンド で振動構造をとらえた例は他に存在せず、振電相互作用の考察 に重要である。



Fig.3 に Fig.2 のスペクトルの高エネルギー側の領域の拡大図を 示す。LUMO+1 と記した 2.5 eV 付近のピークは LUMO 由来準 位より高エネルギー側に存在する最初の非占有準位であることか ら LUMO+1 由来の準位と帰属した。また Fig.3 で青線と青丸で 示したピークは HOMO 由来準位からの光電子放出に伴う正イオ ンの振動基底状態(v+=0)と励起状態(v+=1)に由来するピークであ る。Lx, Lyの破線で示すように、HOMOの v+=0,1 ピークが、2.9、 3.3 eV 付近に近づくと、強度の増大が見られる。これは DBP 分 子内の非占有準位 Lx、Ly と HOMO 準位の間の共鳴励起による 強度増大と考えられる。また 3.6、3.7 eV の非占有準位はそれぞ れ HOPG、DBP 膜上に存在する鏡像準位(IPS)であると帰属した。 IPS は基板のバンドギャップと鏡像ポテンシャルによって形成さ

れる表面非占有準位であり、表面平行方向に は自由電子的にふるまうためs偏光では検出 されない。偏光依存性、膜厚変化による強度 変化から帰属を確認できた。

Fig.4(a)に各ピークの中間状態エネルギーを 光子エネルギーに対してプロットした。3種 類の膜厚の結果を重ねているが、いずれのピ ークのエネルギーも膜厚に対して変化して いないことから電子状態に膜厚依存性はな いと思われる。Fig.4(b)では DBP 分子の DFT 計算の結果を(a)の実験結果と比較した。両者 の LUMO エネルギーを合わせて比較してい

る。LUMO+1 はよく一致しており、Lx と Ly は、それぞれ LUMO+2,3 と LUMO+4 に近い。以上よりフェルミ準位近傍 に存在する非占有準位の帰属を行うことができた。

Fig.4では電子状態の膜厚依存性は見られなかったが、LUMO バンドの微細構造には膜厚依存性が見られた。Fig.5 に 0.6 ML および 1.3 ML 膜の LUMO バンドの拡大図を示す。1.3 MLのスペクトルでは sub ML で観測された 2 つの微細構造 の他に新たなピークが 1.1 eV 付近に観測された。これを緑丸 で示す。このピークは sub ML では強度がとても小さいもの の、膜厚が増えるにつれ、強度が増大する特徴がある。これ はDBPのπスタッキングにより LUMO が低エネルギー側に









シフトしたために生じたものと思われる。詳細はポスター(1P065)で発表する。

## 【参考文献】

[1] T. Kirchhuebel *et al.*, Langmuir, 32, 1981 (2016).